トランジスタ

2SA1455K エピタキシァルフレーア形ドNF ンッコン Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor エピタキシァルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ 高耐圧低周波低雑音増幅用/High Voltage Low Freq. Low Noise Amp.

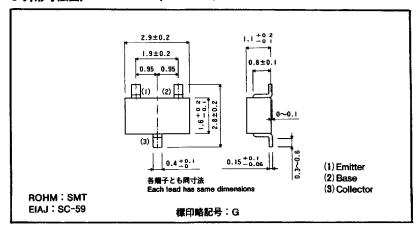
● 特長

- 1) 高耐圧である。V_{CEO}=-120V
- 2) 低雑音である。NF=0.2dB (Typ.) (at $V_{CE} = -6V$, $I_{C} = -100 \mu A$, f=1kHz, $R_g=10k\Omega$)
- 3) 2SC3722Kとコンプリである。

Features

- 1) High breakdown voltage: V_{CEO}=-120V
- 2) Low-noise design: NF=0.2dB (Typ.) (at $V_{CE} = -6V$, $I_{C} = -100 \mu A$, f = 1 kHz, $R_0 = 10k\Omega$)
- 3) Complementary pair with 2SC3722K.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-120	٧	
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-120	٧	
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5	٧	
コレクタ電流	lc	-50	mA	
コレクタ損失	Pc	200	mW	
接合部温度	Tj	150	c	
保存温度範囲	Tstg	-55~150	τ	

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-120	_	_	٧	$I_C = -50 \mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BVCEO	-120	_	_	V	I _C = -1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	- 5	_	_	v	I _E = −50 µA
コレクタしゃ断電流	Ісво	_	_	-0.5	μA	V _{CB} = -100V
エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	_	_	-0.5	μА	V _{EB} = -4V
直流電流増幅率	hFE	180	_	820	-	$V_{CE}/I_{C} = -6V/-2mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE} (sat)	_	_	-0.5	V	$I_{\text{C}}/I_{\text{B}} = -10\text{mA}/-1\text{mA}$
利得帯域幅積	fT	_	140	_	MHz	$V_{CE} = -12V$, $I_E = 2mA$, $f = 30MHz$
コレクタ出力容量	Cob	_	3.2	_	ρF	$V_{CB} = -12V$, $I_E = 0$, $f = 1MHz$
実効値雑音電圧	NV ₁	_	_	150	mV	FLAT AMP (G _V = 80dB)
せん頭値雑音電圧	NV ₂	_	_	14	dB	$V_{CE} = -10V, I_{C} = -1mA$ $R_{g} = 100k\Omega$

hFEの値により下表のように分類します。

Item	R	S	E
hFE	180~390	270~560	390~820

● 標準品・準標準品一覧表 (○:準標準品 △:特別仕様)

		包装名	テーピング	
		記号	T146	T147
Туре	hFE	基本発注単位(個)	3000	3000
2SA1455K	RSE		0	Δ

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

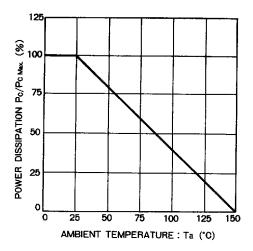


Fig.1 電力軽減曲線

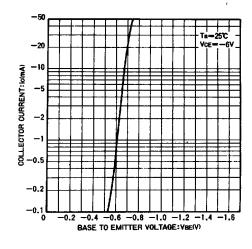


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

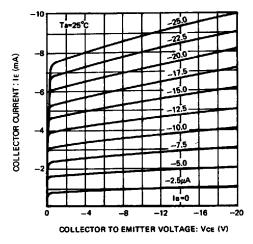


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

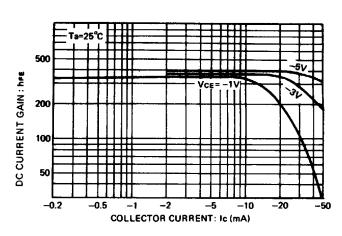
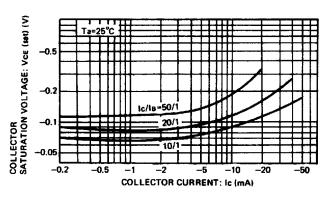


Fig.4 直流電流増幅率ーコレクタ電流特性



、Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧--コレクタ電流特性

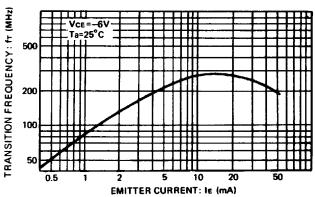


Fig.6 利得帯域幅積ーエミッタ電流特性

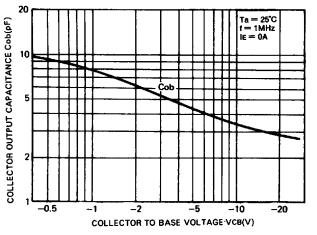


Fig.7 コレクタ出力容量-コレクタ・ベース電圧特性

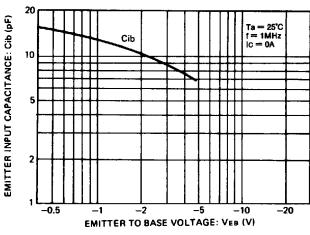


Fig.8 エミッタ入力容量 -- エミッタ・ベース電圧特性

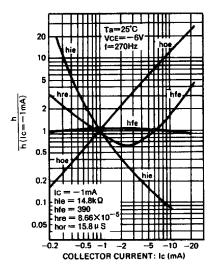


Fig.9 h定数 -- コレクタ電流特性

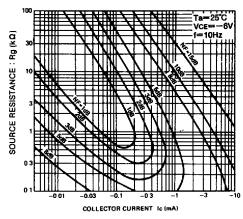
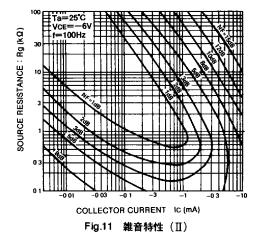


Fig.10 雑音特性 (I)



COLLECTOR CURRENT . IC (mA)

Fig.12 雑音特性(Ⅲ)